

● 静电场基本性质

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{高斯定理: } \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i \text{ 有源场} \\ \text{环路定理: } \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \text{无旋场} \end{array} \right.$$

● 电势差和电势（电位）

1. 电势差、电势的定义:

$$\left\{ \begin{array}{l} V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ V_p = \int_p^{V=0} \vec{E} \cdot d\vec{l} \end{array} \right.$$

● 点电荷的电势

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (V_\infty = 0)$$

2. 电势的计算

1) 定义法

$$V_p = \int_p^{V=0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$A = q \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = q(V_a - V_b)$$

2) 叠加法

$$V_P = \sum_i V_i = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$

$$V_P = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

注意：

1° 电场中某点的“ V ”由场源电荷及场点位置决定，与 q_0 无关。

2° 电势是标量，有正、负。

3° 电势是相对量，是相对于 $V=0$ 处而言。
原则上可选电场中任意一点的电势为零。

一般地：


理论上，电荷分布在有限空间，取无穷远为 $V=0$ 点。

电荷分布在无限空间，取有限远点为 $V=0$ 点。

工程上，通常选大地或设备外壳为 $V=0$ 点。

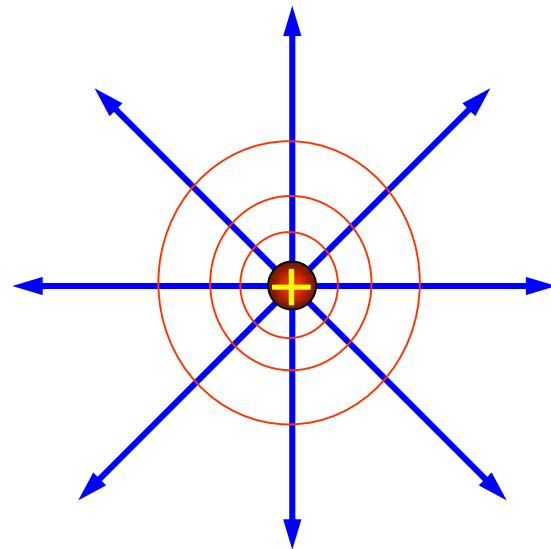
3. 等势面

电场中所有电势相等的点构成的曲面称为**等势面**（实验可测定）。

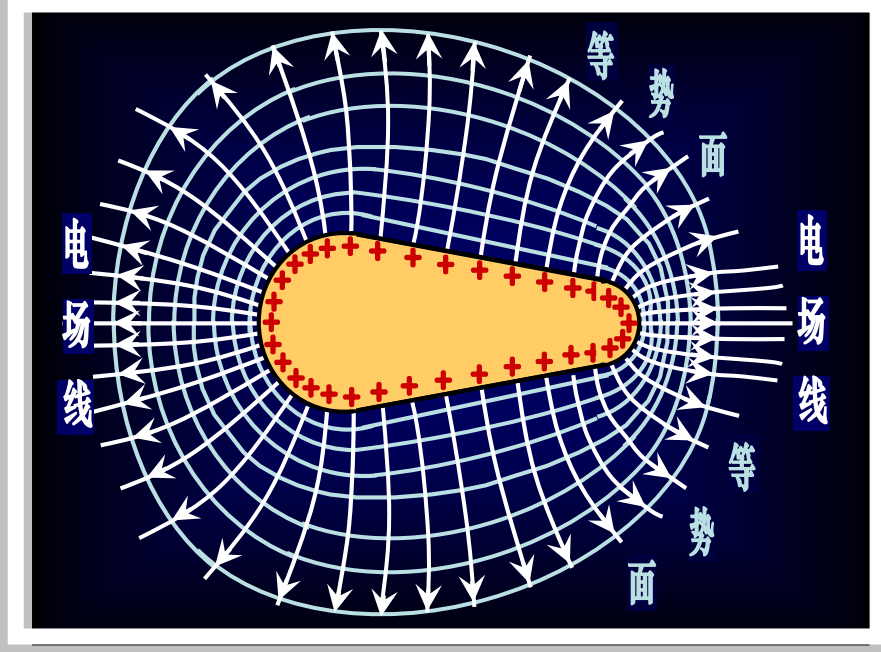
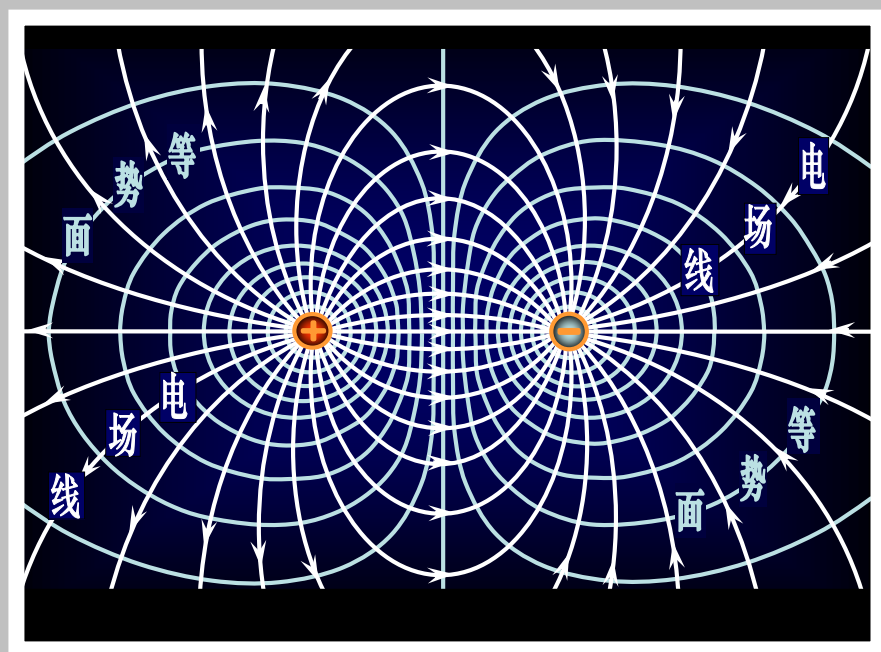
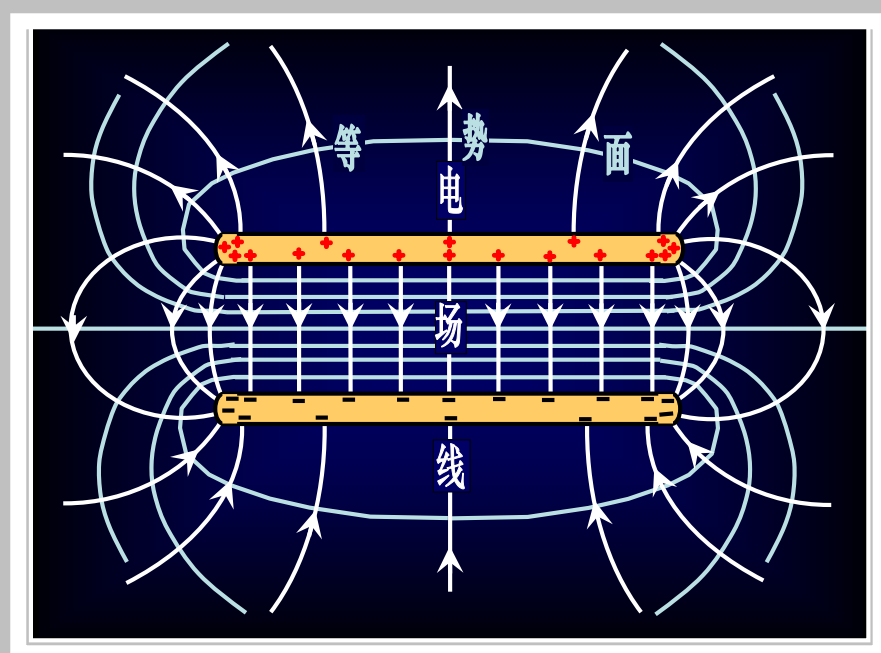
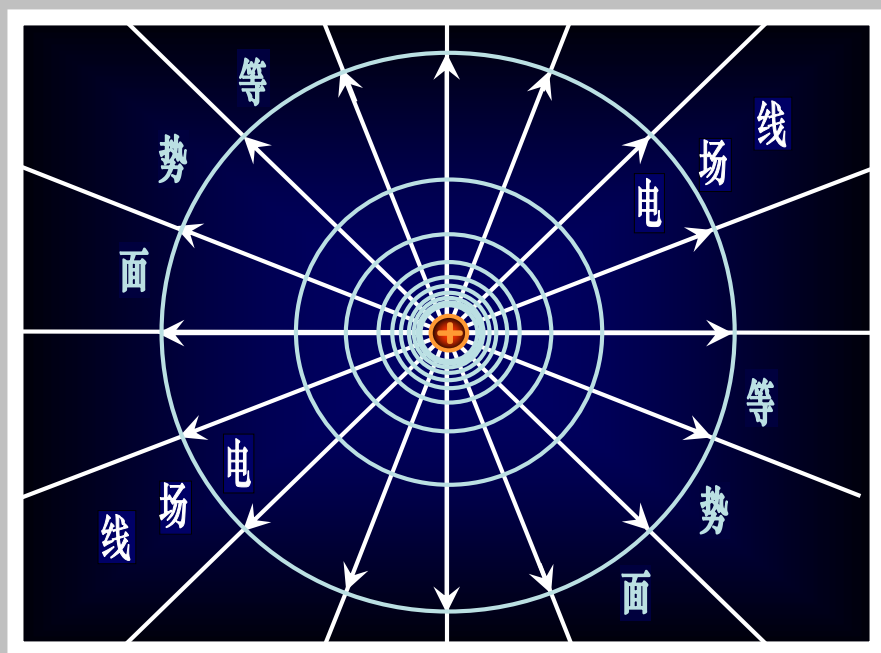

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

等势面与电场分布的关系：

- (1) 电场线与等势面处处正交；
- (2) 电场线指向电势降低的方向；
- (3) 当相邻等势面电势差相等时，
等势面密处的场强大，疏处的场强小。
- (4) 在同一等势面上移动电荷，电场力不做功。



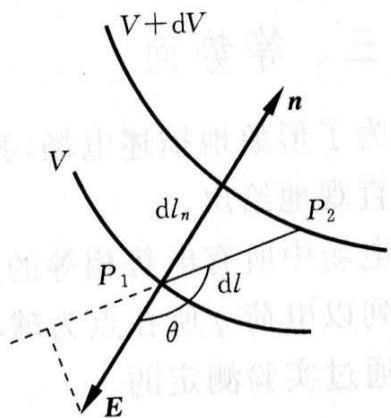
$$A_{ab} = q(V_a - V_b)$$



4. 电势梯度($\text{grad } V$)

 $V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 表示 \vec{E} 与 V 的积分关系。

考虑电场中任意两个相距很近的点 P_1 、 P_2 的电势差。



$$V_{P_1} - V_{P_2} = \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

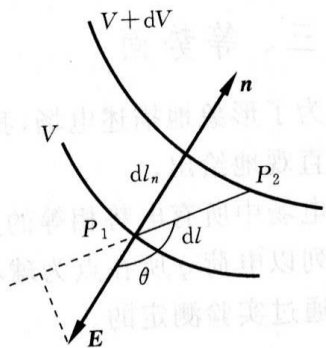
$$V_{P_1} - V_{P_2} = -dV$$

$$-dV = \vec{E} \cdot d\vec{l} = Edl \cos \theta$$

$$\text{即 } E \cos \theta = -\frac{dV}{dl}$$

沿 P_1 、 P_2 的连线方向上的场强分量的大小。

P_1 、 P_2 为电场中任意两个相距很近的点。



$$E \cos \theta = - \frac{dV}{dl}$$

沿 P_1 、 P_2 的连线方向上的场强分量的大小。

若 P_1 、 P_2 沿 x 轴方向，则有
$$\begin{cases} E \cos \theta = E_x \\ dl = dx \end{cases}$$

亦即 $E_x = - \frac{dV}{dx}$

同理 $E_y = - \frac{dV}{dy}$

$E_z = - \frac{dV}{dz}$

$$V = V(x, y, z)$$

改写

$$E_x = - \frac{\partial V}{\partial x}$$

$$E_y = - \frac{\partial V}{\partial y}$$

$$E_z = - \frac{\partial V}{\partial z}$$


又 $\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$

故：

$$\begin{aligned}\vec{E} &= -\left(\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k}\right) \\ &= -\left(\frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}\right)V\end{aligned}$$

$$= -\text{grad}V = -\nabla V$$

电势梯度



$$\begin{cases} E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \\ E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \\ E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} \end{cases}$$

$$\vec{E} = -\text{grad}V$$

$$\vec{E} = -\nabla V$$

(电场强度与电势的微分关系)

电场中某点的场强 \vec{E} 等于该点电势梯度的负值。

据此，可根据电势分布计算电场强度。

前面已有场强叠加原理、高斯定理等两种计算电场强度的方法。

$$E \cos \theta = -\frac{dV}{dl}$$

电势沿 $P_1 P_2$ 方向的空间变化率

此变化率的大小随方向而变,当 $\theta=0$ 时最大。

$$E = -\left. \frac{dV}{dl} \right|_{\max}$$

故, 场强的大小是 P 点附近电势的最大空间变化率。

$$\vec{E} = -gradV$$

→ 电场中某点处的电势梯度, 是该点处电势的最大空间变化率。

电势的梯度与场强的关系(数学推导): $V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$

$$V_a - V_b = -(V_b - V_a) = -\Delta V_{ab}$$

$$= -\int_a^b dV = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\therefore -dV = \vec{E} \cdot d\vec{l} = (E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}) \cdot (dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k})$$

$$= E_x dx + E_y dy + E_z dz$$

$$-dV = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz\right)$$

$$-\left(\frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz\right) = E_x dx + E_y dy + E_z dz$$

$$(E_x + \frac{\partial V}{\partial x}) dx + (E_y + \frac{\partial V}{\partial y}) dy + (E_z + \frac{\partial V}{\partial z}) dz = 0$$

$$\therefore E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} \quad V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k}\right)$$

$$\therefore \vec{E} = -\left(\frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}\right)V$$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

$$\therefore \vec{E} = -\nabla V = -\text{grad } V$$

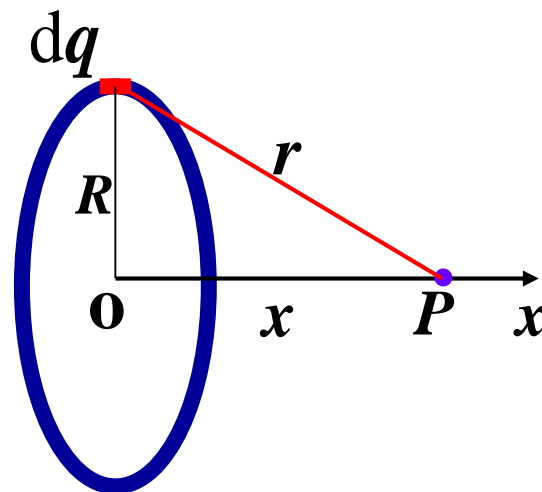
$$\text{grad} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

$$\therefore E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

例：求均匀带电 Q ，半径为 R 的圆环轴线上任意一点的场强。

解：根据电势叠加原理，
 P 点的电势

$$V_P = \int_Q \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$
$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}}$$



P 点的电场： $\vec{E}_P = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k}\right)$

$$\therefore \vec{E}_P = -\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} = \frac{Qx}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}\vec{i}$$

即，沿 x 轴方向。

七、静电场中的导体

1. 导体的静电平衡

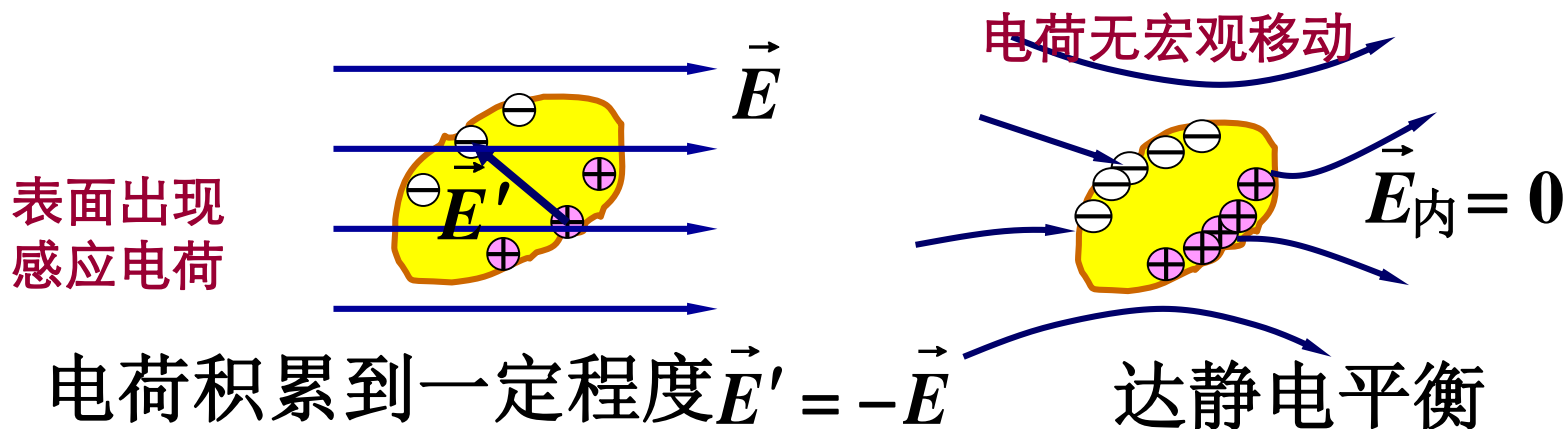
实物 { 导体
 半导体
 电介质(绝缘体)

导体在电场中的特点:

(1) 导体内的自由电荷在电场力作用下移动, 使原有的电荷分布发生变化。

(2) 电荷分布的变化, 反过来影响总的电场分布。

例如: 在均匀场放入一导体。



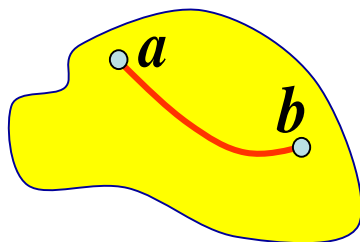
2. 导体的静电平衡条件

导体表面和内部都没有电荷的定向运动

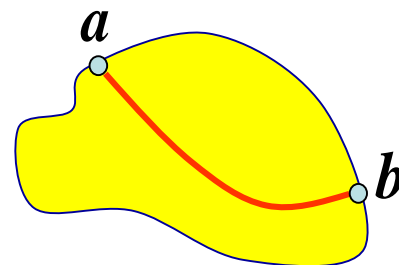
静电平衡条件 $\left\{ \begin{array}{l} \text{导体内部 } \vec{E} = 0 \\ \text{外表面 } \vec{E} \perp \text{表面} \end{array} \right.$ (反证法)

另一种说法: 导体是等势体, 并且导体表面是等势面。

证明:



$$V_a = V_b$$



$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

3. 静电平衡时导体上的电荷分布

(1) 导体内部没有净电荷, 电荷分布在外表面上。

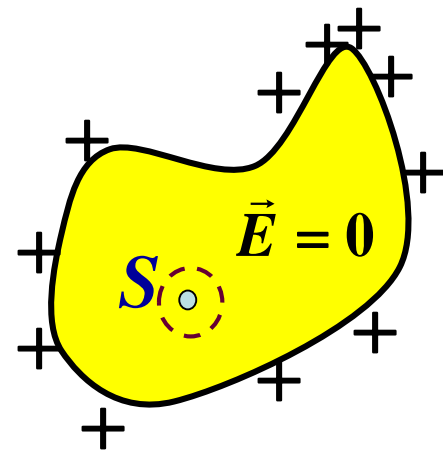
证明: *a. 体内无空腔*

在导体内任选一点, 作高斯面*S*将其包围。

根据高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

已知静电平衡时,
导体内部各处 $\vec{E} = 0$

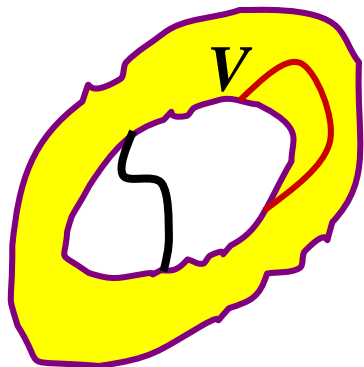


那么 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$ 则有 $\sum_{S_{\text{内}}} q_i = 0$

\therefore 导体内部没有净电荷。

b. 体内有空腔，腔内无其它带电体

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



电荷全分布在导体外表面上。

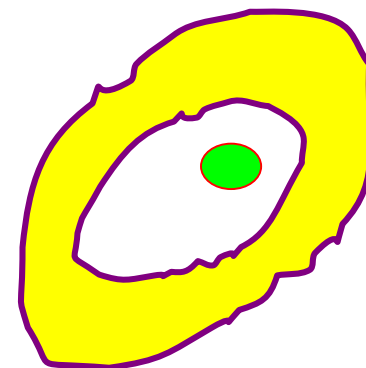
在静电平衡下,内表面是等势面。

因为内表面上任意两点可用经过导体内部的路径连接。故电势必定相等。

若内表面上有电荷，则根据电场线的性质，必定会得出与上面相矛盾的结论。

∴ 电荷全分布在导体外表面上。

且在空腔内，电场处处为零。



若腔内有其它带电体,则内表面上也有电荷。

例：半径为 R 的金属球与地相连接，在与球心相距 $d=2R$ 处有一点电荷 $q(>0)$ ，问球上的感应电荷 $q'=?$

解： 金属球是等势体。

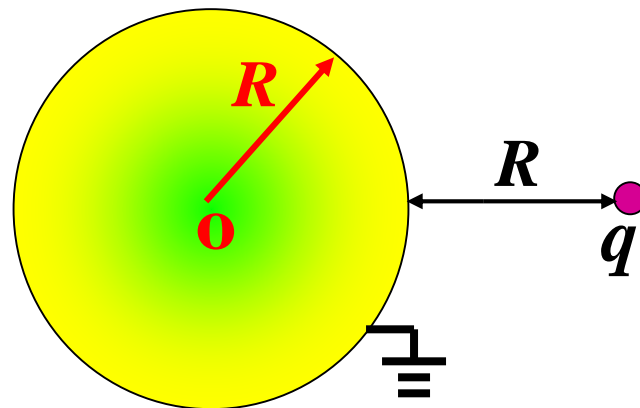
球体上处处电势： $V=0$

球心处： $V_o=0$

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0 2R} + \int_0^{q'} \frac{dq'}{4\pi\epsilon_0 R} = 0$$

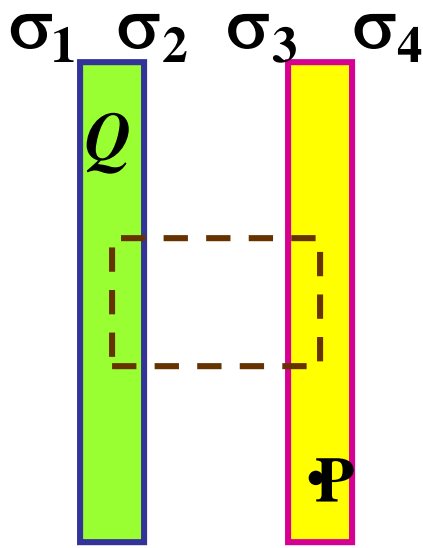
$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0 2R} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R} = 0 \quad \therefore q' = -\frac{q}{2}$$

实际上，以上取了 $V_{\text{地}} = V_{\infty} = 0$ 。



例：一金属平板，面积为 S 带电 Q ，在其旁放置第二块同面积的不带电金属板。求 (1)静电平衡时，电荷分布及电场分布。 (2)若第二块板接地？忽略边缘效应。

注： 1)达静电平衡，导体内部无净电荷。
 2)不考虑边缘效应，电荷是均匀分布。



解： (1)设四个面上电荷面度为 $\sigma_1 \ \sigma_2 \ \sigma_3 \ \sigma_4$

则有： $\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q}{S}$

$\sigma_3 + \sigma_4 = 0$

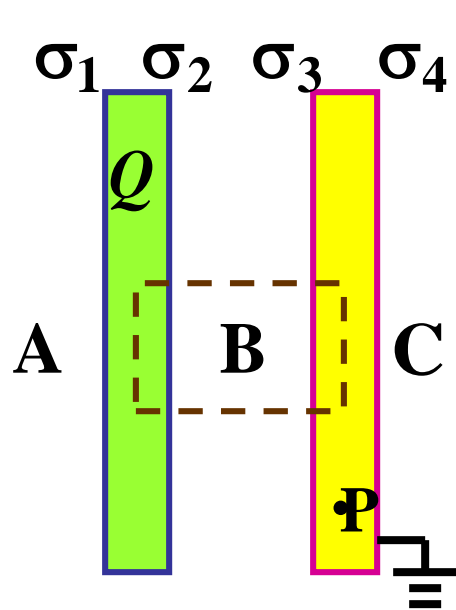
如图取高斯柱面可得： $\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$ $\sum q_i = 0$

即： $\sigma_2 + \sigma_3 = 0$

导体内任意一点P，其电场 $\vec{E} = 0$ **联立求解**

$\therefore \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0$

可得： $\sigma_1 = \sigma_2 = \frac{Q}{2S}$ $\sigma_3 = -\frac{Q}{2S}$ $\sigma_4 = \frac{Q}{2S}$



$$\sigma_1 = \sigma_2 = \frac{Q}{2S} \quad \sigma_3 = -\frac{Q}{2S} \quad \sigma_4 = \frac{Q}{2S}$$

按场强叠加原理可求得:

$$E_A = -\frac{Q}{2\epsilon_0 S} \quad E_B = \frac{Q}{2\epsilon_0 S} \quad E_C = \frac{Q}{2\epsilon_0 S}$$

(2) 第二板接地

则 σ_4 与大地构成一导体 $\sigma_4 = 0$

同理可得:

$$\begin{cases} \sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q}{S} \\ \sigma_2 + \sigma_3 = 0 \\ \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0 \end{cases}$$

联立求解得: $\sigma_1 = 0 \quad \sigma_2 = \frac{Q}{S} \quad \sigma_3 = -\frac{Q}{S}$

$$E_A = E_C = 0 \quad E_B = \frac{Q}{\epsilon_0 S}$$

(2) 导体表面附近 \vec{E} 的大小与该处的面电荷密度 σ 成正比

证明：如图取高斯面 S

根据高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

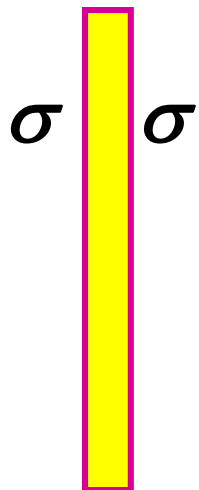
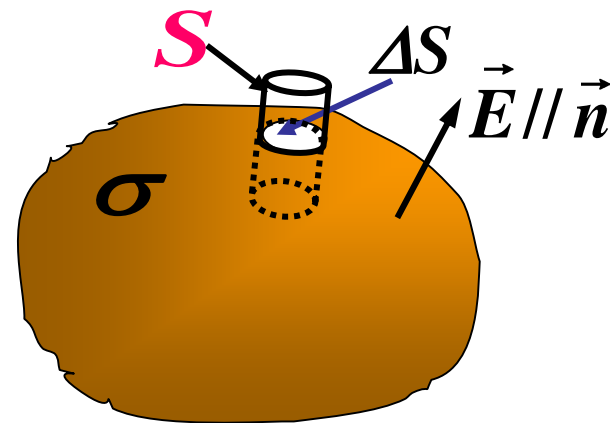
则有

$$E \Delta S = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma \Delta S$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

矛盾？
一致！

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$



1° \vec{E} 是导体表面电荷及外面电荷的合场强！

2° 上式并不给出 σ 的分布。 σ 的分布较复杂。

一般导体的电荷分布与其形状及附近的其它带电体有关。

(3) 孤立导体表面上各处的面电荷密度 σ 与各处表面曲率半径 R 成反比

$$\text{即: } \sigma \propto \frac{1}{R}$$

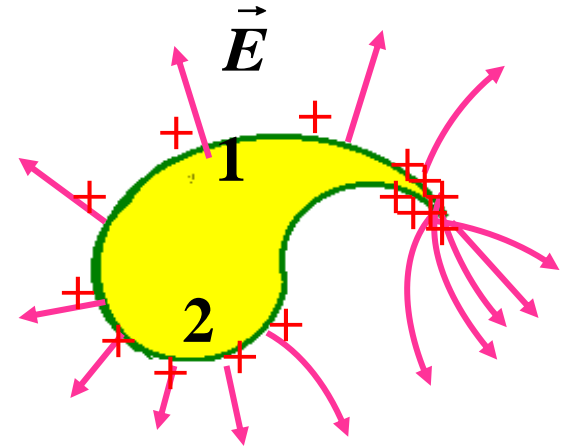
如右图中1、2两处的面密度分别为 σ_1 、 σ_2

$$\text{则有 } \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

平坦处: R 大 σ 小, 则 E 小;

尖端处: R 很小, σ 很大, 则 E 很强; → 尖端放电

凹面处: 曲率为负值, σ 很小, 则 E 很弱。



4. 静电屏蔽

导体壳：（静电平衡时）

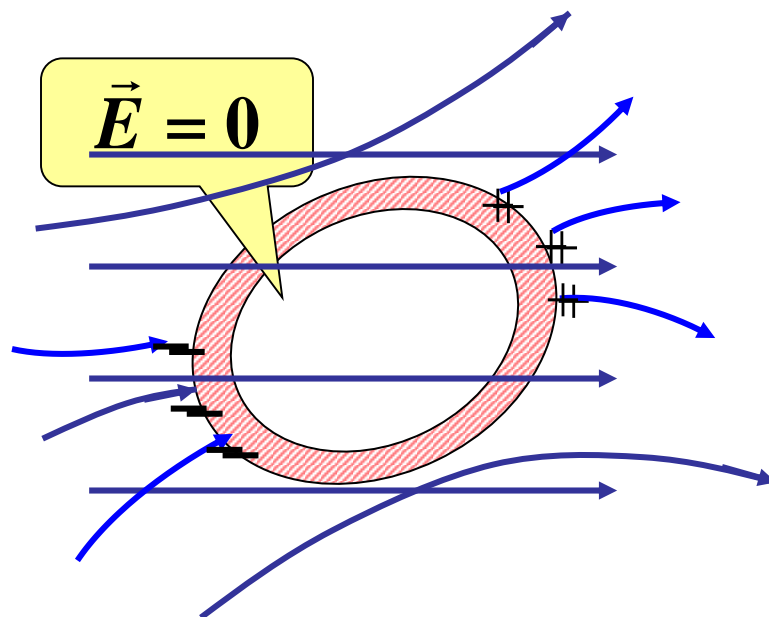
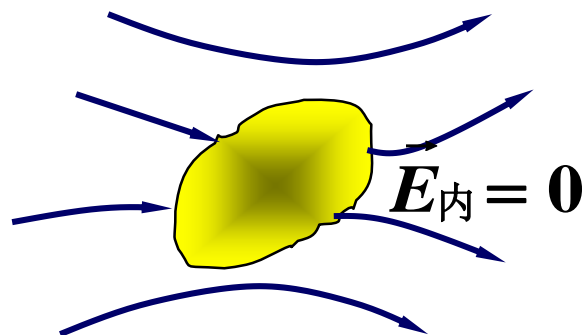
(1) 腔内无带电体情况

{ 内表面无电荷
腔内 $\vec{E} = 0$ （无场区）

外部电场不影响内部

—— 静电屏蔽。

—— 屏蔽外场

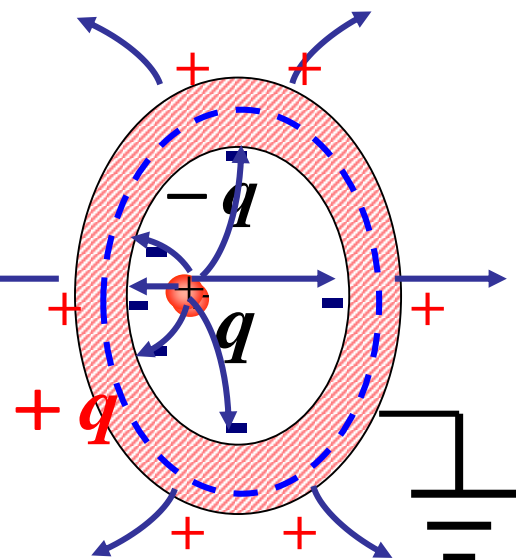


(2) 腔内有带电体情况

导体壳感应带电：

内表面电荷与腔内电荷**等值异号**
(用高斯定理可证明)

外表面电荷与腔内电荷**等值同号**
(若导体壳带电 Q 则外表面上电荷为 $Q+q$)

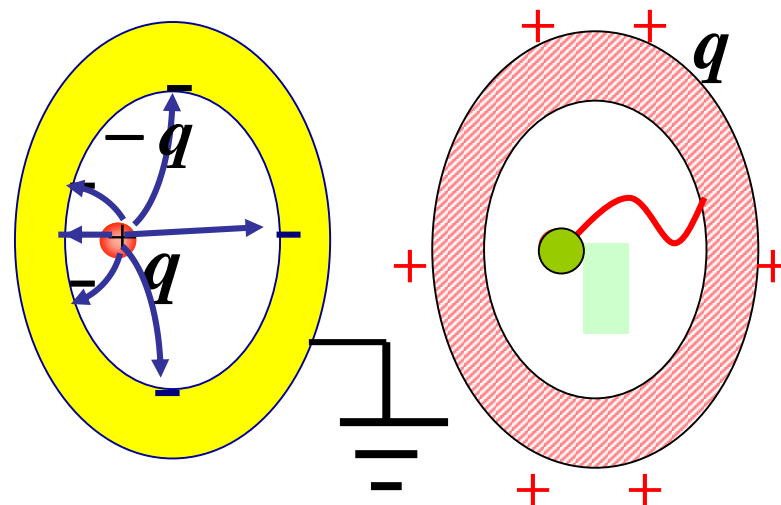


导体壳接地：

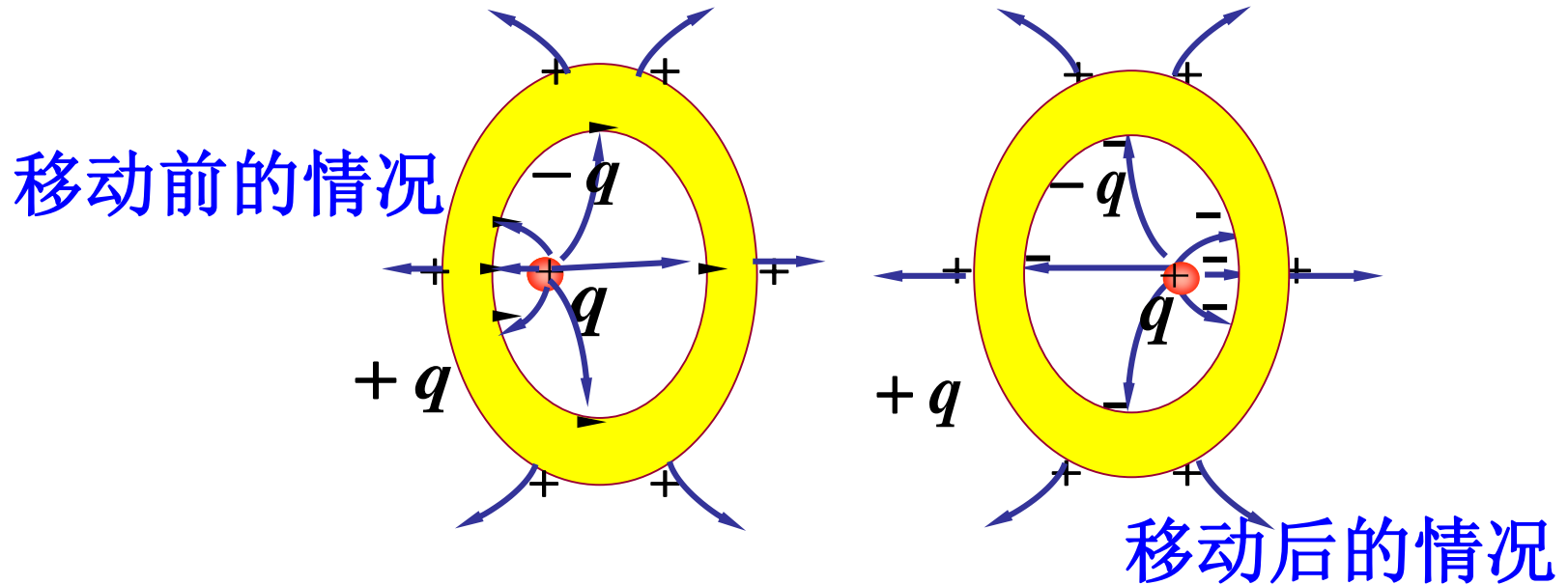
内部电场不影响外部

——**静电屏蔽。**

——**屏蔽内场**



腔内电荷 q 移动时:



内表面带电总量 “ $-q$ ” 不变,

$\sigma_{\text{内}}$ 改变, 腔内电场分布情况改变。

外表面带电总量 “ $+q$ ” 不变,

$\sigma_{\text{外}}$ 不变, 壳外电场分布不变。

例：如图所示，两个相距很远的、半径分别为 r 和 R 的带电导体球由一根细导线连接在一起。已知两者总的带电量为 Q 。试比较两带电球的电荷面密度的大小及带电量。

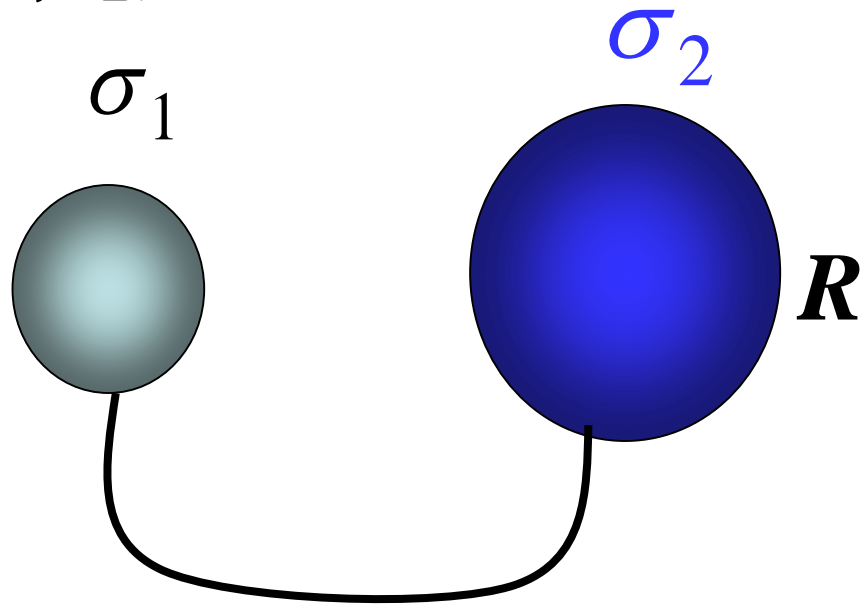
解：设两球的电荷面密度分别为 σ_1 和 σ_2 。

因相距很远，两球上的电荷都是均匀分布于外表面。

两球由导线连接，所以两者的电势相等，即 $V_1=V_2$ 。

$$V_1 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma_1 \cdot 4\pi r^2}{4\pi\epsilon_0 r} = \sigma_1 \cdot r / \epsilon_0$$

$$V_2 = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\sigma_2 \cdot 4\pi R^2}{4\pi\epsilon_0 R} = \sigma_2 \cdot R / \epsilon_0$$



$$\therefore \sigma_1 \cdot r = \sigma_2 \cdot R$$

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R}{r} > 1$$

可见，曲率大处电荷密度大

作业： 6 —T14、 T15、 T16

本次课重点：

- 1.静电场的电介质与计算**
- 2.静电场中导体的特征**